■ 公募情報

公募No.	2022R-14
職種	有期研究員
部署	未来ＩＣＴ研究所　小金井フロンティア研究センターグリーンＩＣＴデバイス研究室
研究テーマ	酸化ガリウムデバイスの研究開発（デバイスプロセス）
研究テーマ要旨	新規ワイドギャップ半導体材料である酸化ガリウム（Ga2O3）を用いたトランジスタ、ダイオードに代表される電子デバイスの基盤技術の研究開発。主に、Ga2O3デバイスプロセスを担当する。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	電気電子工学、もしくは物性物理分野での博士の学位を有すること、またはそれと同等程度の経験（企業における研究、生産現場での5年以上の実務）を有すること。半導体デバイスプロセス、特性評価に関する研究開発における3年程度以上の実務経験を有するもの。特に、ワイドギャップまたは化合物半導体（GaN, SiC, GaAs等）デバイスプロセス、特性評価に関する経験を有する者が望ましい。
募集人員	2 人
本年度契約期間	採用日　～　令和5年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に,最長令和8年3月31日
給与(本給)	465,000円　～　506,000円/月 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地	本部 (東京都小金井市)
勤務頻度	週5日（週37時間30分勤務）　※時間外労働有

※ 部署名および勤務地名称（研究テーマ名、研究テーマ要旨内の記載を含む）に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。